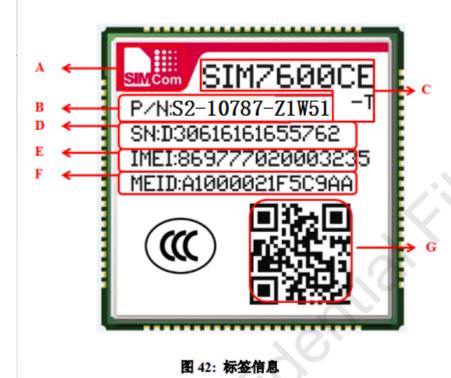


# SIM7600系列产品型号介绍与硬件设计注意事项

2019年4月



模块选刑介绍,



A:LOG

B:产品代码

C:项目名称

D:模块SN号

E:模块IMEI号

能信息模块MEID号 G:二维码

备注:

产品代码: 10787这栏代表模块硬件版本, Z1W51代表

模块的软件版本

IMEI号: 是唯一合法有效的信息,不建议客户自行修

改;一旦IMEI号码不合法,有些网络运营商

会拒绝模块注册网络。

二维码扫描出信息组成:

P/N:S2-10787-Z1W51:

SN:D30616161655762;

IMEI:869777020003235:

MEID: A1000021F5C9AA:

SW:LE11B11SIM7600M22

模块选型介绍:

产品推广时需要了解到客户方案中,主要应用到功能信息:

- 1、语音业务
- 2、GNSS业务
- 3、WIFI/BT(BLE4.1)
- 4、LAN
- 5、PA型号



根据国内市场,SIMCom根据客户不同业务需求,国内细分模块型号如下表:

Ordering Code	SIM7600CE-L	SIM7600CE-M	SIM7600CE-JT	SIM7600CE-T	SIM7600CE-T42	SIM7600CE-AT (SGMII,LCC+LGA)
Category	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4
频段	7模15频*	7模15频*	7模15频*	7模15频*	7模15频*	7模15频*
VoLTE	N	N	Υ	Υ	Υ	Υ
WIFI	N	N	Υ^	Y^	Υ <sup>Λ</sup>	Υ <sup>Λ</sup>
BT	N	N	Υ^	Υ^	Υ <sup>Λ</sup>	Υ <sup>Λ</sup>
HW code	S2-107BL	S2-107Q3	S2-107QG	S2-10787	S2-107QP	S2-107QS
PA	RFMD	RFMD	RFMD	RFMD	RFMD	RFMD
Open Linux	N	N	Υ	Υ	Υ	Υ
GNSS	N	Υ	N	Υ	Υ	Υ
Flash (Gbit)	2+1	2+1	2+2	2+2	4+2	4+2
Α !'						
Audio	N	N	Υ	Υ	Υ	Υ
LTE Rx- diversity	N	N Y	Y N	Y	Y	Y



根据国内市场,SIMCom根据客户不同业务需求,国内细分模块型号如下表:

Ordering Code	SIM7600CE-L1	SIM7600CE-L1C	SIM7600CE-M1	SIM7600CE-JT1C	SIM7600CE-JT2C
Category	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4	LTE CAT4
频段	7模15频*	7模15频*	7模15频*	7模15频*	7模15频*
VoLTE	N	N	N	Υ	Υ
WIFI	N	N	N	N	Υ <sup>^</sup>
BT	N	N	N	N	Υ <sup>^</sup>
HW code	S2-1081X	S2-106RZ	S2-1087N	S2-106RX	S2-106RY
PA	RFMD	骆达	骆达	骆达	骆达
Open Linux	N	N	N	N	Υ
GNSS	N	N	Υ	N	N
Flash (Gbit)	1+1	1+1	1+1	1+1	2+2
PCM	N	N	N	Υ	Υ
LTE Rx- diversity	N	N	Υ	N	N
FOTA	N	N	N	N	Υ



# SIM7600系列功能列表

功能块	型号及Memory(bit) 2+2: 2Gb ROM + 2Gb RAM 2+1: 2Gb ROM + 1Gb RAM 1+1: 1Gb ROM + 1Gb RAM	SIM7600CE-A SIM7600CE-T SIM7600CE-JT	SIM7600CE SIM7600CE-M SIM7600CE-L SIM7600CE-CM SIM7600CE-CU	SIM7600CE-JT1C (新分区,支持 Volte和 Voice call)	SIM7600CE-L1C (无语音,纯数 据业务,新分 区)	SIM7600CE-M1 SIM7600CE-L1 (无语音,纯数 据业务; 老分区)
		2+2	2+1	1+1	1+1	1+1
	PCM	Y	N	Y	N	N
	VOLTE	Y	N	Y	N	N
	CSFB	Y	N	Y	N	N
语音业务	SRLTE(Only for CDMA)	Y	N	Y	N	N
相关功能	USB Audio	Y	N	Y	N	N
107C-97 BE	DTMF	Y	N	Y	N	N
	多媒体播放 (AMR, MP3, WAVE, 录音)	Y	N	N	Y	N
	TTS	Y	N	N	Y	N



# SIM7600系列功能列表

功能块	型号及Memory(bit) 2+2: 2Gb ROM + 2Gb RAM 2+1: 2Gb ROM + 1Gb RAM 1+1: 1Gb ROM + 1Gb RAM	SIM7600CE-A SIM7600CE-T SIM7600CE-JT	SIM7600CE SIM7600CE-M SIM7600CE-L SIM7600CE-CM SIM7600CE-CV	SIM7600CE-JT1C (新分区,支持 Volte和 Voice call)	SIM7600CE-L1C (无语音,纯数 据业务,新分 区)	SIM7600CE-M1 SIM7600CE-L1 (无语音,纯数 据业务; 老分区)
		2+2	2+1	1+1	1+1	1+1
	Multiple APN	Y	N	N	N	N
	FTP/HTTP/DNS/	Y	Y	Υ	Υ	Y
	FTPS/HTTPS/SSL TLS1.2	Y	Y	Υ	Υ	Y
	SMTP	N	N	N	N	N
	SMTPS	N	N	N	N	N
	MQTT/MQTTS	Y	Y	Y	Y	Y
数据业务	阿里云功能	Y	N	N	N	N
相关功能	中国移动DM	Y	N	N	N	N
4107C-9118E	PPP拨号	Y	Y	Y	Y	Y
	NDIS拨号数据业务	Y	Y	Y	Y	Y
	MBIM(Only Win8 OS)	Y	Y	Y	Y	Y
	RNDIS	Y	N	N	N	N
	网络时间同步	Υ	Υ	Υ	Υ	Y
	LBS	Y	Y	Υ	Υ	Y
	Fota	Υ	Υ	N	N	N
	艾拉OTA	Y	N	N	N	N
	广升FOTA下载	Υ	Υ	N	N	N



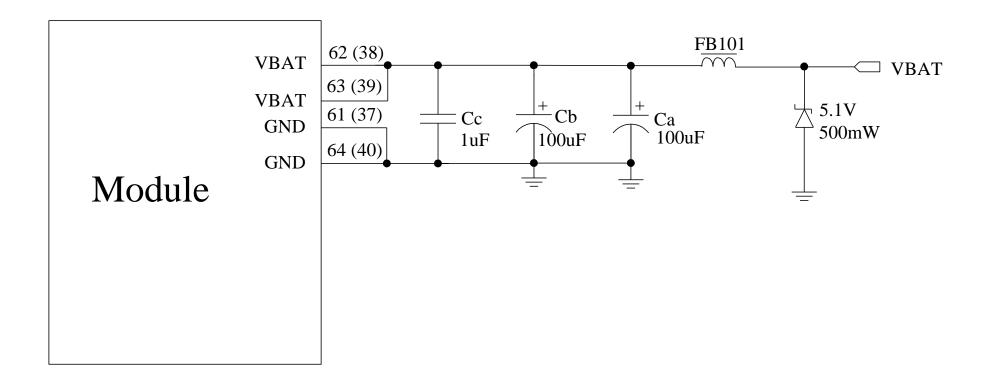
# SIM7600系列功能列表

功能块	型号及Memory(bit) 2+2: 2Gb ROM + 2Gb RAM 2+1: 2Gb ROM + 1Gb RAM 1+1: 1Gb ROM + 1Gb RAM	SIM7600CE-A SIM7600CE-T SIM7600CE-JT		SIM7600CE-JT1C (新分区,支持 Volte和 Voice call)	SIM7600CE-L1C (无语音, 纯数 据业务, 新分 区)	SIM7600CE-M1 SIM7600CE-L1 (无语音,纯数 据业务; 老分区)
	()	2+2	2+1	1+1	1+1	1+1
di (1871)	Uart(CMUX)	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
串口通讯	USB	Υ	Υ	Y	Υ	Y
及驱动相关的业务	Sleep and wakeup	Y	Y	Y	Y	Y
关的业务 功能	Android ril reference lib(2.3,4.0,4.2,4.4, 5.0,5.1,6.0,7.0)	Y	Y	У	Y	Y
GNSS相关	GPS/GLONASS/BEIDOU2	Y	Y 部分模块硬	Y	N	N
功能	伽利略/QZSS	Y	Y 部分模块硬	Y	N	N
	HSIC转以太网	Y	N	N	N	N
	SD	Y	N	N	N	N
扩展功能	WIFI热点	Y	N	N	N	N
扩展初用的	BT	Y	N	N	N	N
	Ecall Ecal	Y	N	N	N	N
	SIM卡热插拔	Y	Y	Y	Y	Y
定制功能	Linux二次开发环境	Y	N	N	N	N



VBAT引脚原理图部分设计

供电范围3.4-4.2V之间,推荐3.8V,建议客户端一定预留齐纳二极管的设计方案。





如何计算电容?

主要由电源的最大输出电流决定。

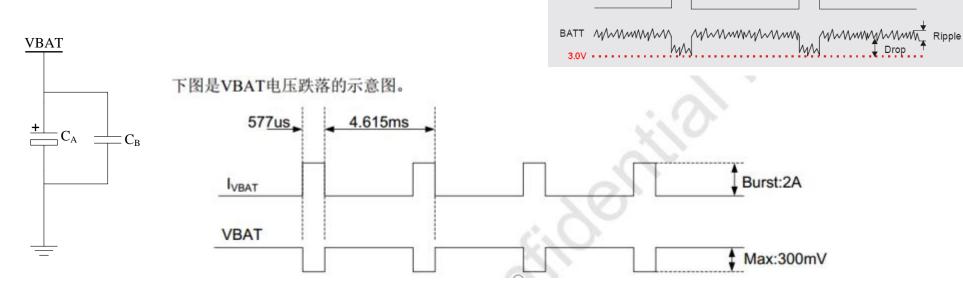
例如,电源的输出能力为500mA@4V,对于模块2A的瞬间峰值电流,电容取值是多少?

如果模块的工作电压为 $3.6^{\circ}4.2V$ ,那么电压的压降应该低于4V-3.6V=0.4V,下降时间为0.577ms。

 $\triangle$ Qneed=  $\triangle$ It=(Imax-I)t=(2A-0.5A)\*577\*10<sup>-6</sup>

 $\triangle Q$ need =  $\triangle Q$ cap=C  $\triangle U$ =C\*0.4V

C=  $\triangle$ Qneed /0.4V= = (2A-0.5A)\*577\*10<sup>-6</sup> /0.4V=2164uF



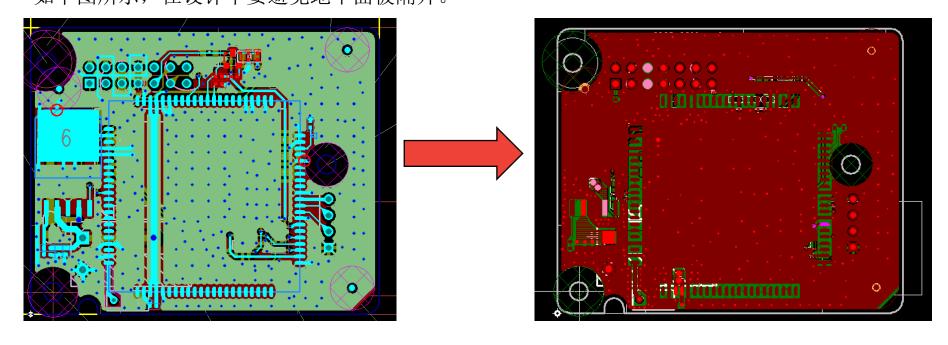


Transmit

Transmit

### VBAT引脚PCB走线设计

为了得到好的电源平面,用户在设计SIM7600的电源部分走线设计时,可以仅对pin38/39走线,或仅对pin62/63走线,因为在SIM7600模块内部这4个引脚是连接在一起的。如下图所示,在设计中要避免地平面被隔开。

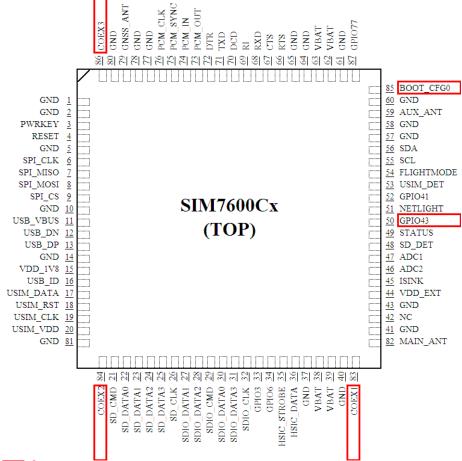


BAD GND Plane GOOD GND Plane

开机过程问题点

用户需要注意在开机过程中如下引脚不能被上拉,否则模块无法正常开机。

Pin 50-----GPI043 Pin 83-----COEX1 Pin 84-----COEX2 Pin 85-----B00T CFG0 Pin 86-----COEX3





芯讯通无线科技(上海)有限公司 www.simcom.com

#### SIM7600系列开机时间说明:

目前4G模块,和我们使用的Android智能手机基本是一样的架构,和传统的手机相比,目前Android智能手机开关机时间也是普遍变长.(USB reday在15s左右,具体详见HD)

SIM7600系列模块主要是由modem+AP两部分组成, linux主要在AP侧运行, 普通的AT交互处理在 modem侧.



要点:对模块执行正常关机,再进行VBAT掉电。

模块开机运行机制:模块运行在DDR中,程序存储在NAND Flash中。

实际使用时,如果模块正在工作中,模块在注册网络,PPP/TCP/IP等数据业务操作,AP部分启动运行等,这些数据信息都要存储在flash中暂时性保存或一直保存,此时突然性的给模块VBAT断电,那么NAND Flash中数据可能就无法及时处理或释放,时间久了,因为目前电子器件存在离散性,个别模块可能就会因为flash长期不能正确操作使用,flash中文件系统被损坏,导致模块不能正常开机。

另外,模块自身会有这类异常处理保护措施,但这些终归都是软件上的保护,VBAT直接断电是硬件上的一个异常处理,即便软件如何保护,也是有限的处理,如果我们在使用中,可以做到,在可以控制的情况下,使用pwrkey拉低正常关机,就会正常的操作模块flash,这样也是对文件系统的保护;当然车载类设备不可避免的异常断电,这种时候,我们的文件系统保护也会起到效果,这样大家都按照正常的处理方式,模块使用才会更加稳定。

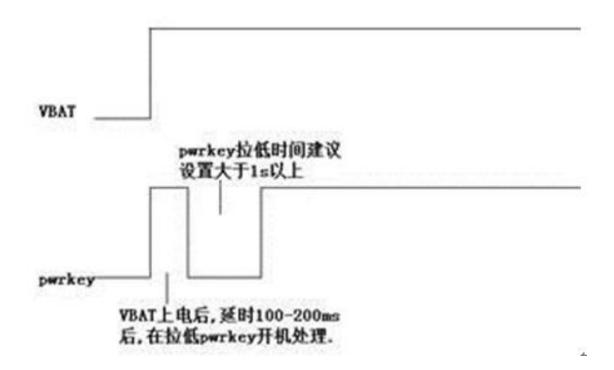
- 模块应用中出现软件无法处理的异常状态,使用模块PWRKEY引脚进行开关机。
- AT不响应, 模块pwrkey关机无效等情形, 再考虑执行reset功能或VBAT掉电。

推荐RESET拉低时间:最小值100ms,最大值500ms,一直垃低会造成模块一直重启。

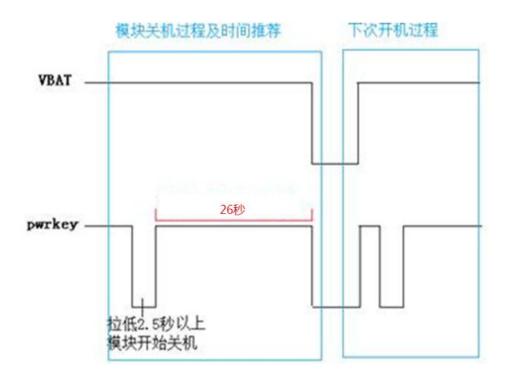


### 客户控制模块开机逻辑:

VBAT上电后,到PWRKEY拉低,最好间隔100-200ms以上时间,以便电源输出稳定。



模块关机时间及下次开机推荐时序处理

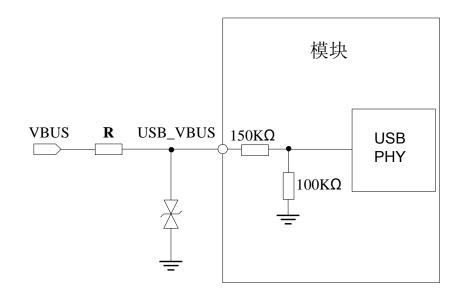


延时26秒目的:主要保证模块正常网络注销及USB设备释放,到达彻底关机的用途.



### USB\_VBUS的内部设计

在SIM7600的模块内部, 利用100K和150K的电阻, 将USB\_VBUS引脚的电压进行2/5分压为了确保USB被成功识别,USB\_VBUS 的推荐电压为 $3.0^{\sim}5.25$ V 。如果用户在模块外部 串联一个电阻R,则这个电阻的取值需要经过计算得到。



### 模块USB和Host之间连接

模块USB只能作为从设备使用, 开机后映射如下端口信息:

ttyUSBO:debug使用

ttyUSB1:获取GPS部分NMEA信息

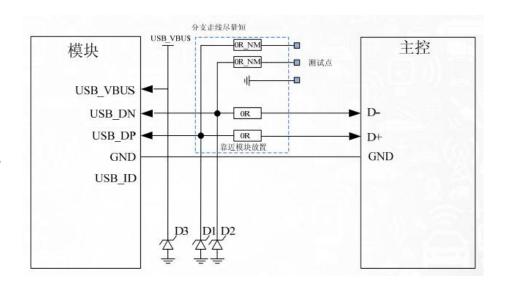
ttyUSB2:AT com

ttyUSB3:Modem com ttyUSB4:USB Audio

ttyUSB5:RNDIS拨号

D1, D2的负载电容需要小于1pf;

模块的VBUS连接情况会影响模块能否正常进入休眠, 当主机支持 suspend和resume机制时,不需要关注。 当主机不支持suspend和resume机制时,在模块休眠前, 客户需要 USB VBUS引 断开,不然无法进休眠。





USB layout 参考

SIM7600系列具有1个HS-USB 2.0接口,最高速度为480Mbps,模块不支持充电功能。

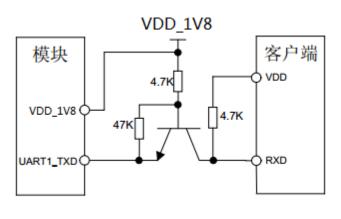
Layout应该遵循以下原则:

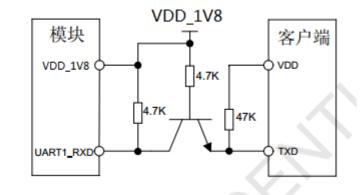
- 90 **Q** 差分阻抗, 误差率±10%
- 差分信号线匹配3.8 mm (150 mils)
- 外围的元件应该靠近USB连接器放置
- 信号上升/下降沿的变化速率较快,应远离敏感电路和信号 (RF、 audio 、 19.2 MHz晶振)
- 不推荐在USB线上串联开关
- TVS器件靠近USB接口放置

### UART串口部分

模块串口部分电平1.8V,一般MCU电平3.0/3.3V左右,建议最好选择电平转换芯片,或者选择 三极管隔离方式.

注意:模块部分上拉选择15pin(VDD\_1V8)





TX 连接图

RX 连接图

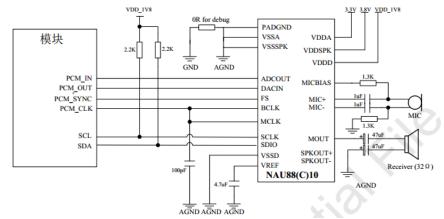
#### 音频部分

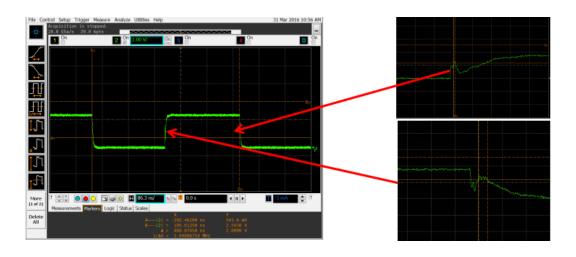
- 模块提供PCM数字音频接口,参考HD/ATC文档;
- 1. 推荐客户选择模块端已调试过的codec芯片(NAU8810)。

其中: PCM\_CLK是敏感信号, 应远离其他信号;

PCM\_CLK端连接100pF电容作用,PCM\_CLK如果有毛刺干扰,导致模块在发送语音数据给Codec时,提前出现了有效的PCM\_CLK上升沿。(靠近codec放置)

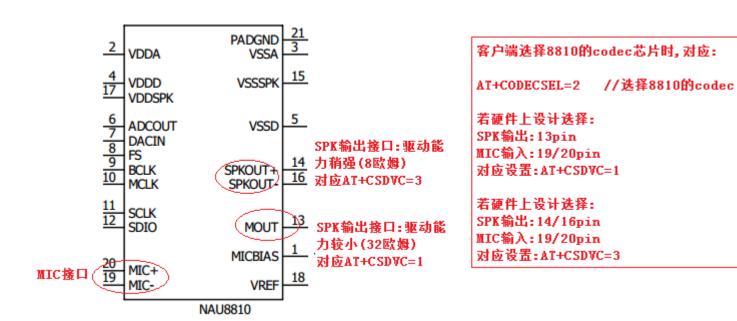
#### PCM推荐电路如下图:





### 音频部分

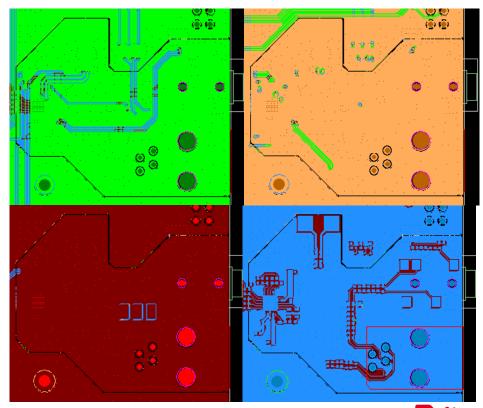
车载类客户使用NAU8810 codec时候,建议选择SPKOUT,主要是驱动能力稍强一些;除非客户端还有功放器件。



### Codec电路Layout注意事项

为了避免TDD噪声,强烈建议ANA\_GND和MAIN\_GND分隔开。

下图为SIM7600-EVB codec部分的截图,其中ANA\_GND和MAIN\_GND利用一颗磁珠分隔开。ANA GND \_GND建议设计为平面, 孤立的走线作为AGND抗干扰能力较弱。



#### 音频部分

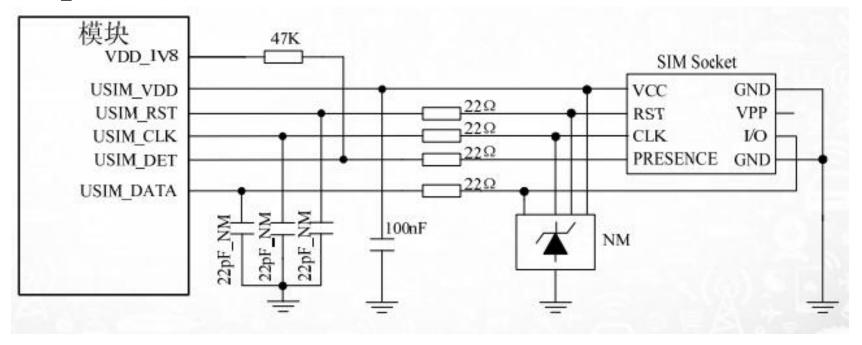
```
音频参数调试
AT+Cacdbfn=?
+CACDBFN: (Handset_cal.acdb, Handset_tianmai.acdb)
OK
AT+Cacdbfn=Handset tianmai.acdb
                                      // 建议考虑设置这组参数
OK
A. 模块开机初始化阶段, 在拨打电话之前, 增加如下
AT PWRCTL=0, 1, 3
                                     // 主要改善TDD noise效果
OK
B. 模块建立语音通话过程中
VOICE CALL: BEGIN
                                    // 模块通话建立执行, 改善通话效果
                                    // 回音抑制处理
AT+CECM=1
OK
                                    // 改善手机端音量效果
AT+CECH=0x500
OK
祥见 "SIM7X00_Audio_Application_Note" 文档
```

### 带热插拔功能的USIM卡设计

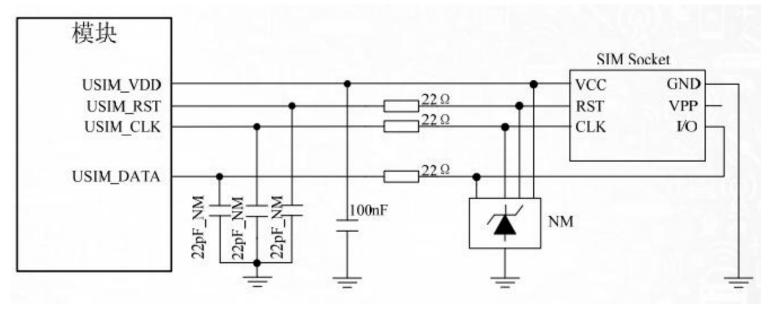
客户可以使用AT+UIMHOTSWAPON=1打开热插拔检测功能.

如果SIM卡座是常开类型的,客户可以设置模块为AT+UIMHOTSWAPLEVEL=0,当检测到USIM\_DET被拉低时,认为SIM卡插入。

如果SIM卡座是常闭类型的, 客户可以设置模块为AT+UIMHOTSWAPLEVEL=1, 当检测到USIM DET \_DET被拉高时,认为SIM卡插入。



不带热插拔功能的USIM卡设计



注意: 模块内部USIM\_DATA已通过20KΩ电阻上拉到USIM\_VDD,外部电路不需要上拉。

另外,在USIM\_VDD上的100nF去耦电容建议必须保留。

#### USIM 卡设计

USIM的特性参考

《Smart Cards;UICC-Terminal interface;Physical and logical characteristics》 用户需要注意USIM信号线的负载电容,负载电容越大,USIM信号线的上升和下降时间越长, 这会导致模块不识别USIM卡。

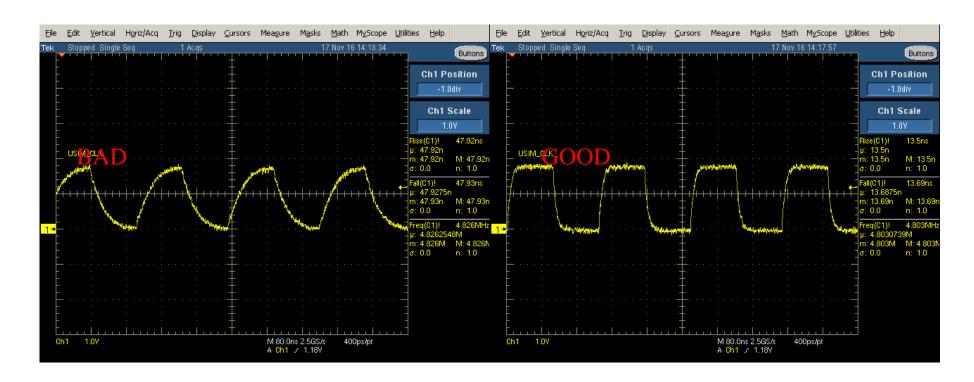
Table 5.11: Electrical characteristics of Clock (CLK) under normal operating conditions

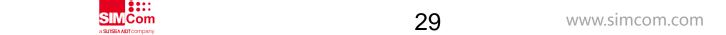
Symbol	Conditions	Minimum	Maximum	Unit		
V <sub>OH</sub>	$I_{OHmax} = +20 \mu A$ 0,7 x Vcc		Vcc (see note)	V		
V <sub>OL</sub>	I <sub>OLmax</sub> = -20 μA	0 (see note)	0,2 x Vcc	V		
t <sub>R</sub> t <sub>F</sub>	$C_{in} = C_{out} = 30 pF$		50	ns		
NOTE: To allow for overshoot the voltage on CLK should remain between -0,3 V and Vcc + 0,3 V						

Table 5.12: Electrical characteristics of I/O under normal operating conditions

Symbol	Conditions	Minimum	Maximum	Unit
V <sub>IH</sub>	I <sub>IHmax</sub> = ±20 μA (see note 2)	0,7 x Vcc	Vcc + 0,3	٧
V <sub>IL</sub>	I <sub>ILmax</sub> = +1 mA	-0,3	0,2 x Vcc	V
V <sub>OH</sub>	I <sub>OHmax</sub> = +20 μA	0,7 x Vcc	Vcc (see note 3)	٧
(see note 1)				
V <sub>OL</sub>	I <sub>OLmax</sub> = -1mA	0 (see note 3)	0,3	<b>V</b>
t <sub>R</sub> t <sub>F</sub>	$C_{in} = C_{out} = 30 pF$		1	μs
			100	ns
			(see note 4)	

下图为2种SIM\_CLK波形图,从图中可以看出,BAD 波形对应的USIM\_CLK 的上升/下降时间为Tr=47.9ns/Tf=47.9ns, GOOD波形对应的USIM\_CLK 的上升/下降时间为Tr=13.5ns/Tf=13.7ns。





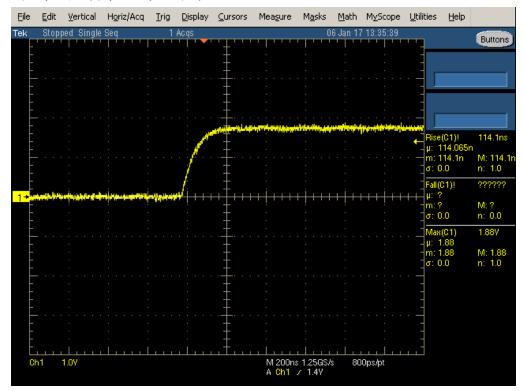
SIM卡周边设计,相关RC器件全部靠近SIM卡座放置,对SIM卡保护效果最佳。

SIM卡电路比较容易受到干扰,引起不识卡或掉卡等情况,所以在设计时请遵循以下原则:

- 在 PCB 布局阶段一定要将 USIM 卡座远离主天线。
- USIM 卡走线要尽量远离 RF 线、VBAT 和高速信号线,同时 USIM 卡走线不要太长。
- USIM 卡座的 GND 要和模块的 GND 保持良好的联通性, 使二者 GND 等电位。
- 为防止 USIM\_CLK 对其他信号干扰,建议将 USIM\_CLK 做单独包地保护处理。
- 建议在 USIM VDD 信号线上靠近 USIM 卡座放置一个 220nF 电容。
- 在靠近 USIM 卡座的地方放置 TVS,该 TVS 的寄生电容不应大于 50pF 的,在 USIM 卡座和模块之间串联 22 Ω 电阻可以增强 ESD 防护性能。
- USIM\_CLK 信号非常重要,客户应保证 USIM\_CLK 信号的上升沿和下降沿时间小于 40ns,否则可能会出现识卡异常的现象。



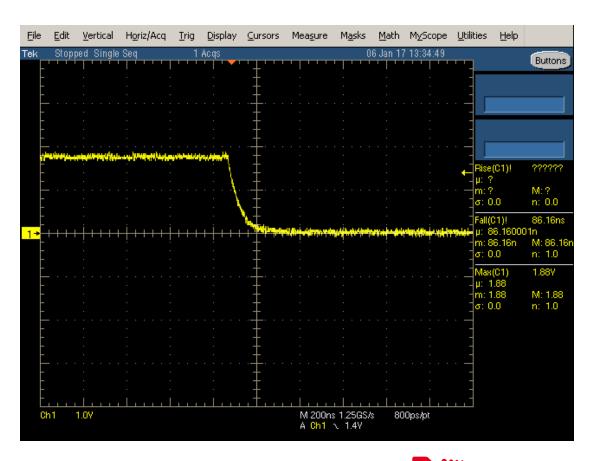
客户案例: SIM\_DATA波形不满足识卡规范要求造成不,测试SIM\_DATA信号,该信号的Tr和Tf分别是114ns和86ns。产生SIM\_DATA上波形上升沿和下降沿过缓原因是阻值和容值过大导致。



图示: SIM\_DATA信号上升沿测试



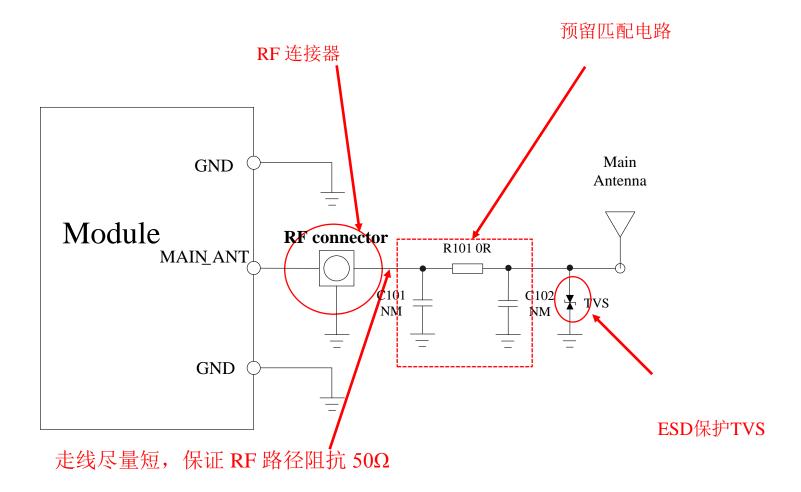
客户案例: SIM\_DATA波形不满足识卡规范要求造成不,测试SIM\_DATA信号。



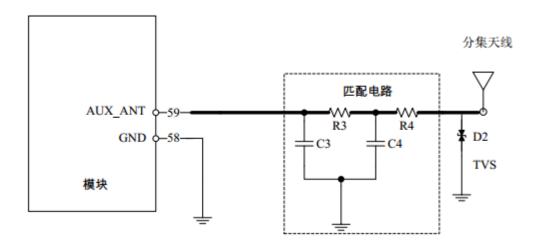
图示: SIM\_DATA信号下降沿测试



RF 主天线电路设计



RF 辅助天线电路设计



如果客户端对射频指标较高,或者会有大数据收发,建议预留辅助天线设计方式。射频指标上:可以提高模块接收灵敏度

实网使用上: 数据下载可能在10M左右的差异

增加分级天线:速度在30M以上 不加分级天线:速度在20M以下

模块传导部分,发射功率

频率	功率
E-GSM900	33dBm ±2dB
DCS1800	$30 dBm \pm 2 dB$
E-GSM900 (8-PSK)	27dBm ±3dB
DCS1800 (8-PSK)	26dBm +3/-4dB
WCDMA B1	24dBm +1/-3dB
WCDMA B2	24dBm +1/-3dB
WCDMA B5	24dBm +1/-3dB
WCDMA B6	24dBm +1/-3dB
WCDMA B8	24dBm + 1/-3dB
CDMA BCO	24dBm + 1/-3dB
TDSCDMA 1900	24dBm + 1/-3dB
TDSCDMA 2000	24dBm + 1/-3dB
LTE-FDD B1	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B2	23dBm +/-2.7dB

LTE-FDD B3	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B4	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B5	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B7	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B8	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B13	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B17	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B18	23dBm +/-2.7dB
LTE-FDD B20	23dBm +/-2.7dB
LTE-TDD B38	23dBm +/-2.7dB
LTE-TDD B39	23dBm +/-2.7dB
LTE-TDD B40	23dBm +/-2.7dB
LTE-TDD B41	23dBm +/-2.7dB



模块传导部分,接收灵敏度

频率	灵敏度(典型)
EGSM900	<-109dBm
DCS1800	<-109dBm
WCDMA 2100	<-110dBm
WCDMA 900	<-110dBm
TDSCDMA 1900	<-110dBm
TDSCDMA 2000	<-110dBm
CDMA BC0	<-110dBm
LTE FDD/TDD	参考表 26

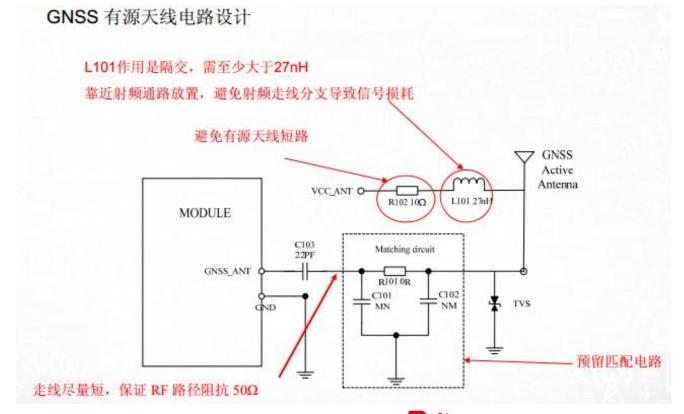
频率范围	走线损耗
700MHz-960MHz	<0.5dB
1710MHz-2170MHz	<0.9dB
2300MHz-2650MHz	<1.2dB

E-UTRA 3GPP 标准					实测值	3GPP 标准		双工
频段编号	1.4 MHz	3MHz	5MHz	10MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz	模式
1	-		-100	-97	-101	-95.2	-94	FDD
3	-101.7	-98.7	-97	-94	-99	-92.2	-91	FDD
8	-102.2	-99.2	-97	-94	-102			FDD
38		-	-100	-97	-101	-95.2	-94	TDD
39	-	-	-100	-97	-101.5	-95.2	-94	TDD
40	-	-	-100	-97	-101	-95.2	-94	TDD
41	-	-	-99	-96	-101	-94.2	-93	TDD

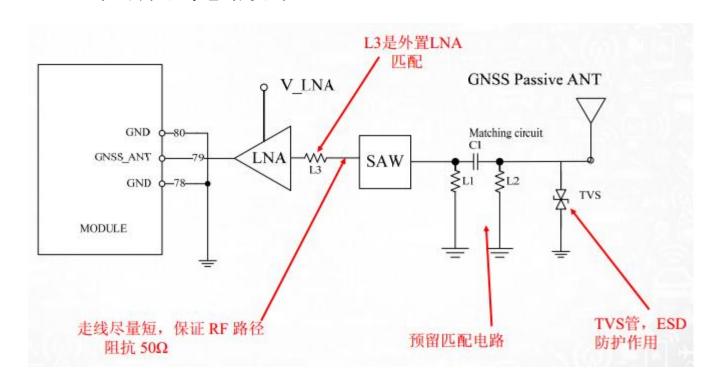
GNSS天线是交流信号,给有源天线供电加电感,作用通直隔交;这样就不会把天线的交流信号传递到电源处,避免信号衰减,同时降低电源纹波。

电容的作用是阻直流, 防止电流进入模块射频引脚。

SIM7600的坐标系都是WGS84,输出的定位信息在不同坐标系应用中需要转换。



### GNSS 无源天线电路设计



有源与无源电路差异:

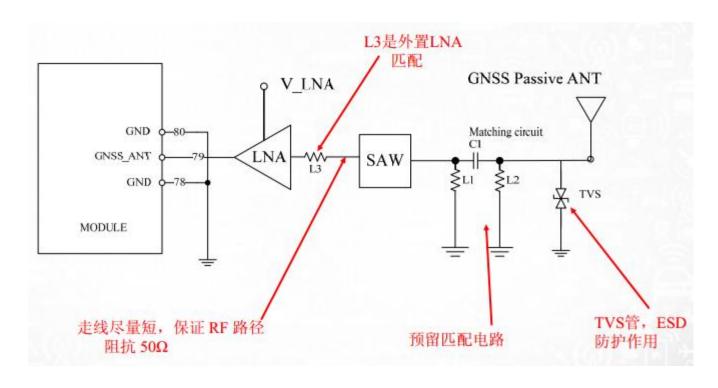
SIMCom提供的开发板,配套的是GPS有源的陶瓷天线,其中有个LNA电路。

SAW: 把用不到的频段过滤掉, 防止干扰, 然后经过LNA放大, 给到模块。

LNA: 作用是把有效信号放大,同时噪声并没有放大,需要外部提供电源。



### GNSS 无源天线电路设计



有源与无源电路差异:

SIMCom提供的开发板,配套的是GPS有源的陶瓷天线,其中有个LNA电路。

SAW: 把用不到的频段过滤掉, 防止干扰, 然后经过LNA放大, 给到模块。

LNA: 作用是把有效信号放大,同时噪声并没有放大,需要外部提供电源。



### 推荐的天线参数

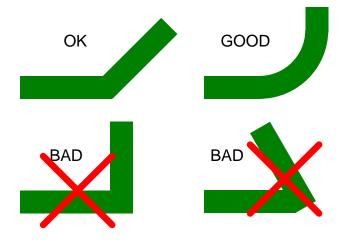
- ■主天线在自由空间的效率大于40%
- ■分集天线在自由空间的效率大于20%
- 主天线和分集天线的隔离度大于8dB
- 如支持WLAN, 主天线和WLAN 天线的隔离度大于15dB
- 如支持GNSS, 主天线和GNSS天线的隔离度大于30dB

### 推荐TVS型号

Decal	Model	Supplier
0201	LXES03AAA1-154	Murata
0402	LXES15AAA1-153	Murata

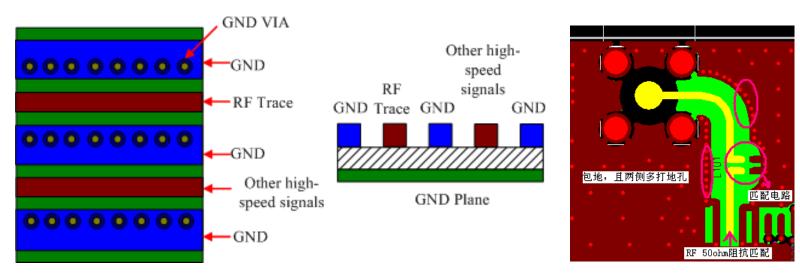
### RF Layout 参考

- 考虑到天线安装位置,为使RF走线尽量短,模块应靠近主板边缘放置。
- RF走线避免直角和锐角走线。



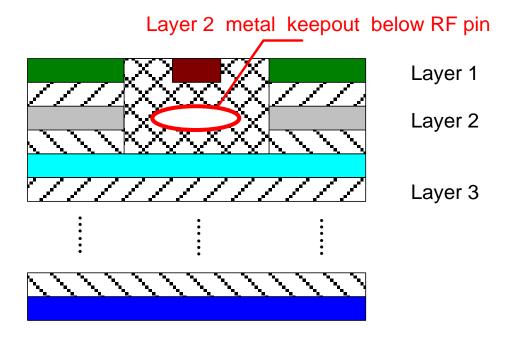
■ RF 走线 (表层的微带线或者内层的带状线) 上下左右包地, 并控制50 Q 阻抗。

- RF走线两边要多打地孔
- RF 走线应远离其他高速信号线

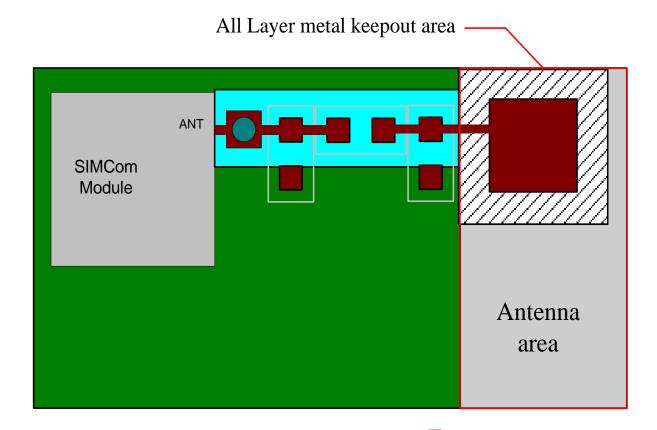


■ 如果使用外置LNA, LNA应尽量靠近GNSS天线放置

■ 模块射频pad对应的Layer2需要禁止铺铜,Layer3层为完整地



■天线馈点从top层到bottom间的各层PCB禁止铺铜



芯讯通无线科技(上海)有限公司







EMC 设计

ESD和浪涌是造成模块损坏的主要原因,所以在系统设计中要做适当的保护。

VBAT/USB\_VBUS/VDD\_1V8 很容易受到ESD和浪涌的干扰,给模块造成不可恢复的损坏。有效的方式是增加TVS 和ZENER 二极管,下表为推荐的型号。

SIM7600 模块抵抗浪涌能力:

VBAT: ± 850V@20A 8/20us----32欧姆

USB\_VBUS: ±1800V@42A 8/20us---32欧姆

No.	Manufacturer	Part Number	Power dissipation	Package
1	On semi	MMSZ5231BT	500mW	SOD123
2	Prisemi	PZ3D4V2H	500mW	D323
3	Vishay	MMSZ4689-V	500mW	SOD123
4	Crownpo	CDZ5V1SM	500mW	0805

#### 原理review checklist

- 软件版本是否确认?(标准/MIFI/SPI/Open CPU/)
- 器件封装是否正确?
- 不能够开机前上拉的引脚是否上拉?
- 对DCDC供电, VBAT是否预留磁珠?
- VBAT供电是否按照手册设计要求3.6-4.2V范围,推荐值3.8V,最大供电电流是否达到2A?
- VBAT摆放电容是否足够?
- VBAT是否有ESD和浪涌防护?
- VBAT是否可以控制断开?以防PWRKEY关机失效?
- VBAT只给38/39供电,或者只给62/63供电?来保证GND没有被分割,模块内部已经连接网络。
- PWRKEY是否由host控制?是否经过电平转换?
- PWRKEY低电平能否达到0.5V以下?
- RESET是否由host控制?
- USB接口是否接到主控? 主控是否支持suspend和resume控制? 如不支持USB\_VBUS是否能和模块断开?

### 原理图review checklist

- VBUS电压范围是否为3~5.25V?
- VBUS是否预留ESD和浪涌防护?
- USIM\_\_CLCK的TVS负载电容是否小于50pf?
- SD卡外部供电电流需要大于350mA
- SD卡是否预留TVS?
- IIC上拉电阻是否为2.2K?
- SD DET是否上拉到VDD 1V8?
- VDD\_1V8不能用于大电流应用,最大输出50mA。
- USB接口是否支持OTG应用?
- VDD EXT开机默认输出2.85V,不能用于SD卡供电。
- ADC采样范围有没有超限?
- ADC 样NSTATUS建议TC电路是否有上拉设计?
- NETLIGHT和使用三极管驱动LED。
- USIM是否支持热插拔, USIM DET对应的AT指令是否设置?
- 客户是否需要分集天线?
- 是否预留BOOT\_CFGO和VDD\_1V8测试点 便 试 方便调试升级?

#### 原理图review checklist

- GPI0连接到主控电平是否匹配?开机后状态是否合理?
- 需要中断输入时,选择的GPIO是否有中断功能?
- UART是否经过电平转换再接到主控?是否确认信号输入输出方向?
- RTS输出, CTS输入, 信号方向确认 确 正确。
- DTR是否由host控制?以方便休眠设计。
- 如果使用三极管做电平转换,速率是否小于115200?
- PCM外接codec默认支持NAU8810,不支持第三方codec。
- PCM CLK是否预留100pf?
- GPS天线是否需要接有源天线?
- 音频电路是否远离远离天线等干扰源?
- 音频模拟地和模拟供电有没有预留磁珠?
- 如果外加大功率音频PA, PA的取电如果选择VBAT, 2G burst时可能会有TDD噪 声
- WIFI电路请参考SIM7600+W58 Reference Design.pdf
- eMMC电路请参考SIM7600 Series EMMC-Reference Design V1.01.pdf
- Ethernet电路请参考7600CE-LAN-Reference Design V1.0



www.simcom.com

### 原理图reviwe checklist

- 电容耐压值是否满足设计需求?
- 电感的DCR, IDC, ISAT是否满足规范?
- 有极性的器件,方向是否设计正确?

